

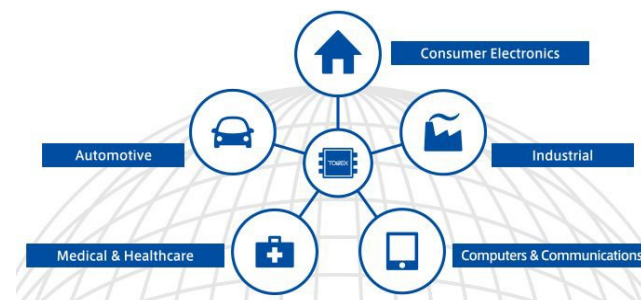
2025年3月期 通期 決算説明資料

2025年 5月20日

トレックス・セミコンダクター株式会社

世界は「アナログ」でできている

あらゆるフィールドで活躍するトレックスの電源IC



1

2025年3月期 通期業績

2

2026年3月期 業績予想

3

株主還元

4

トピックス

Appendix

2025年3月期 通期業績

▶ **トレックスは、日本・欧州市場の停滞により売上が減少したが、前期に生じた棚卸評価損について、今期に一部の戻りが発生したことも収益要因となり、減収増益**

▶ **フェニテックは、アジア市場は回復するも、北米市場の売上が大きく減少し、減収減益**

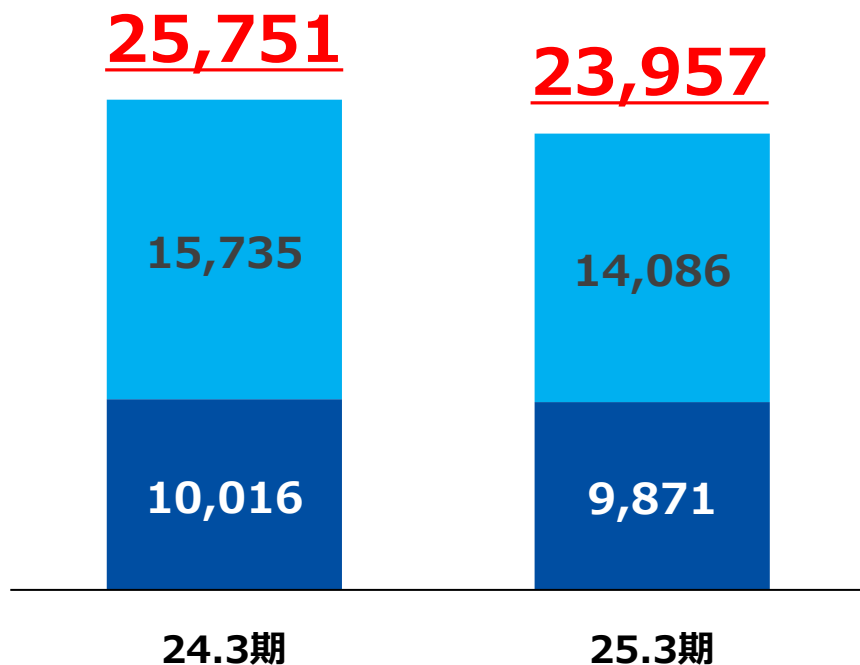
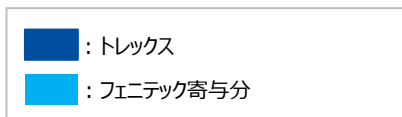
▶ **特別損失として、減損損失が発生。対業績予想は親会社株主に帰属する当期純損益が大きく未達**

(単位：百万円)

科目		24.3期通期 実績	25.3期通期 実績	対前年同期比 増減率
売上高		25,751	23,957	▲7.0%
営業損益		▲1,778	▲632	-
	営業利益率	-	▲2.7%	-
経常損益		▲2,452	▲820	-
親会社株主に帰属する 当期純損益		▲4,297	▲2,358	-
EPS (円)		▲390.73	▲214.62	-
海外売上高比率 (*1)		66.5%	69.4%	2.9pt
平均為替レート (1\$=)		¥144.4	¥152.4	-
減価償却費		2,350	2,468	5.0%
設備投資		5,284	2,950	▲44.2%

(*1)海外売上高比率：外貨建て売上比率

(単位：百万円)

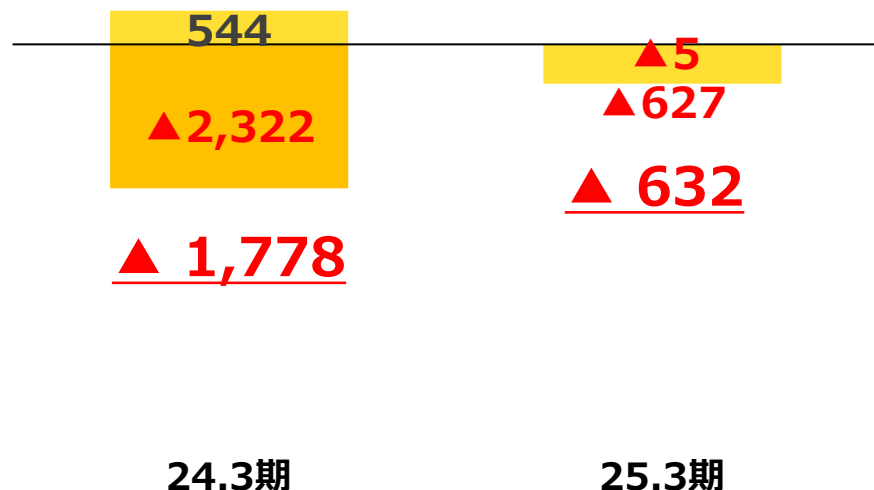
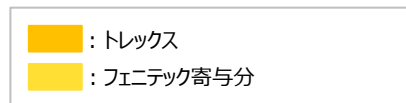


- トレックス （前年同期比▲1.4%）
 - 中国市場は回復しているが、日本・欧州市場が落ち込み、減収
 - 産業機器、一般民生機器分野で減少
- フェニテック （前年同期比▲10.5%）
 - 北米市場が大きく減少し、減収
 - 産業機器分野が大きく減少

(単位：百万円)

	24.3期 実績	25.3期 実績	対前年同期比増減率
売上高	25,751	23,957	▲7.0%

(単位：百万円)



➤ トレックス (前年より23億17百万円増)

- 前期に発生した棚卸評価損※が
今期において戻り、益要因に

※前期：棚卸評価損の発生(損) 23.3億円

当期：棚卸評価損の戻り(益) 2.5億円

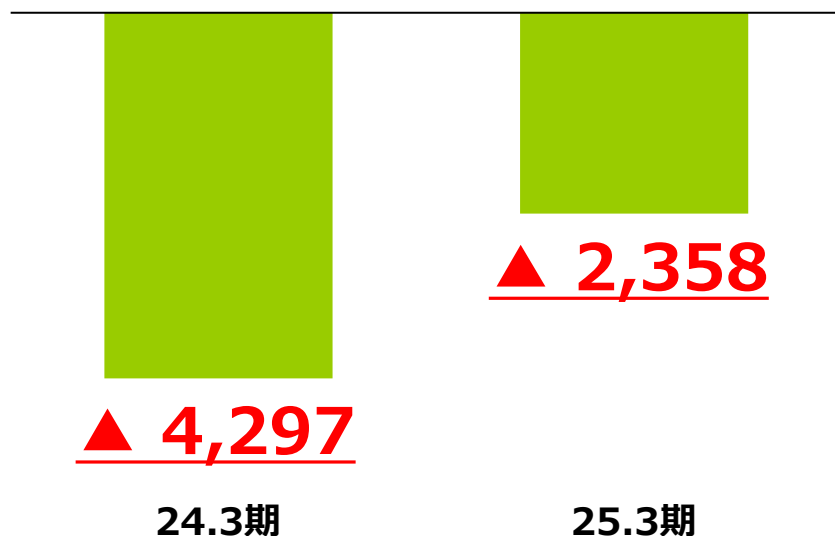
➤ フェニテック (前年より11億71百万円減)

- 売上の減少に伴い、減益

(単位：百万円)

	24.3期 実績	25.3期 実績	前年との差
営業損益	▲1,778	▲632	+1,146

(単位：百万円)



損失額は減少したが、今期においても
11億の減損損失が発生。

※主な昨年度との差異の内訳

営業損失の改善：11.4億円

為替差損の減少：3.7億円

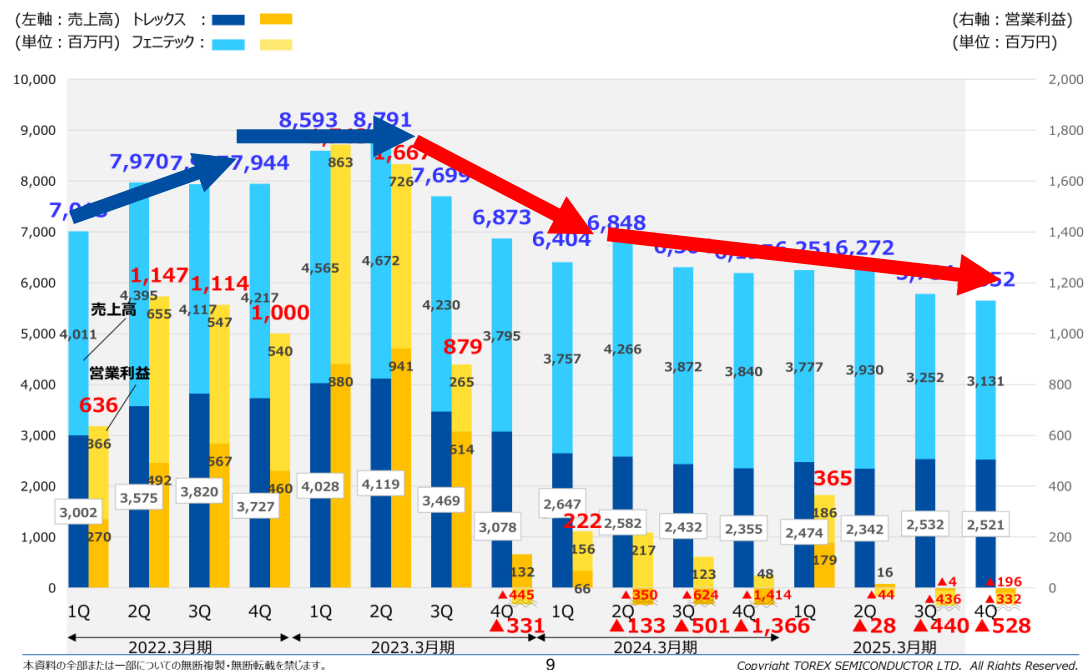
減損損失の減少：5.9億円

(単位：百万円)

	24.3期 実績	25.3期 実績	前年との差
当期純損益	▲4,297	▲2,358	+1,939

● 半導体市場の急成長と当社の売上

売上高・営業利益の四半期推移

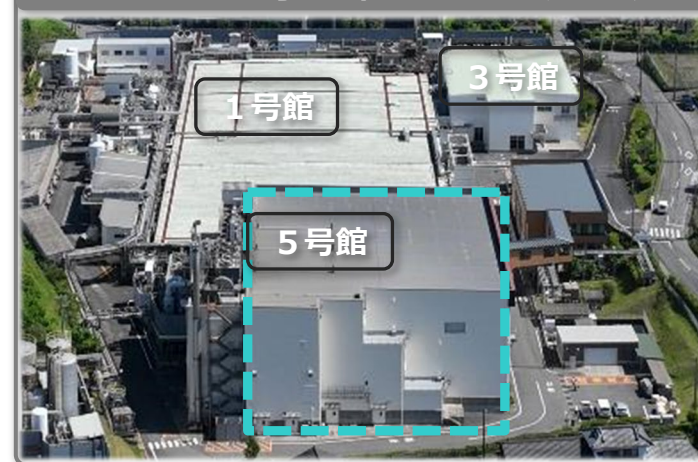


次ページより

● フェニテック鹿児島工場への投資



鹿児島工場5号館3階をクリーンルーム化

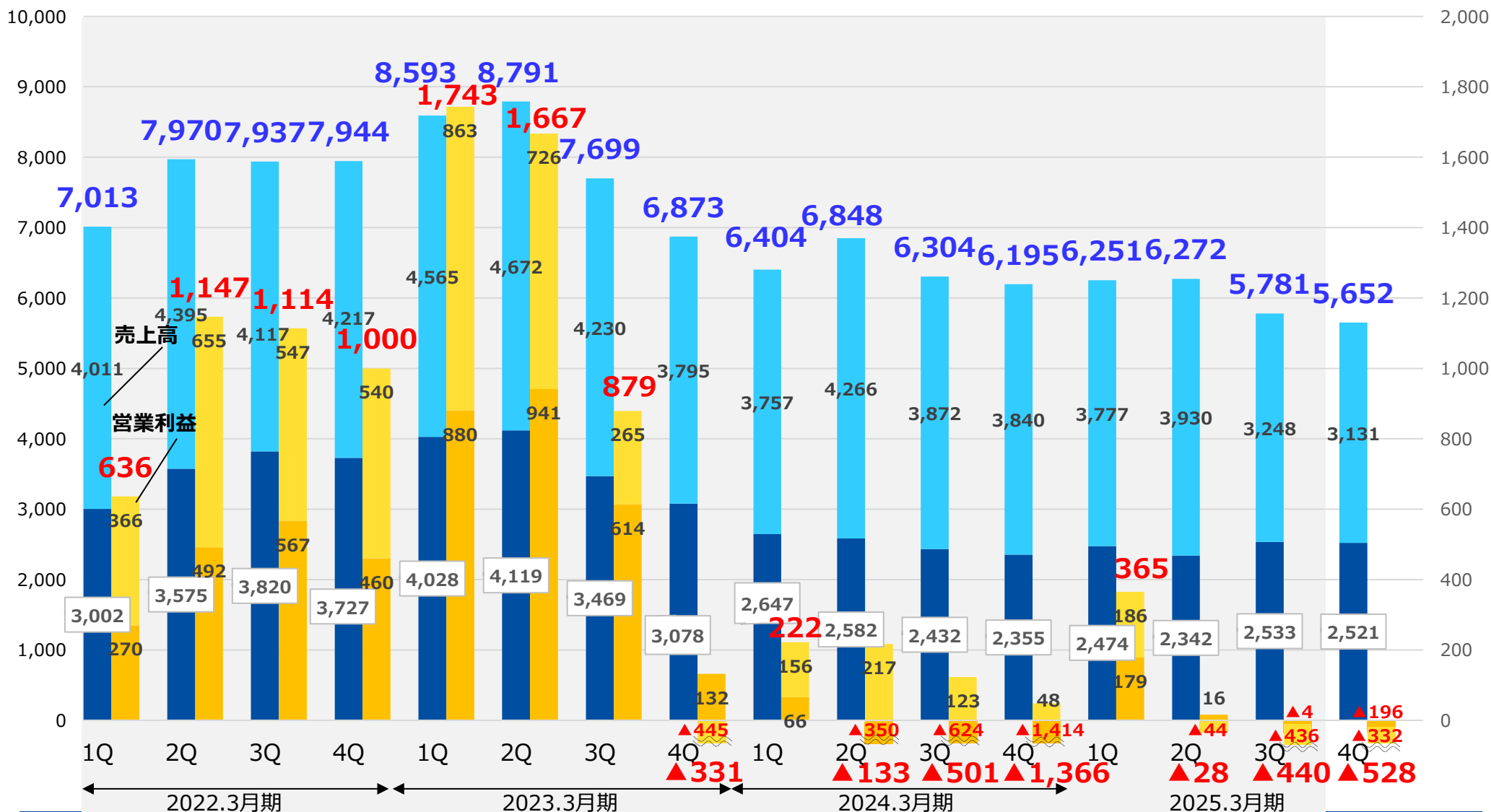


当社 2024年3月期 通期決算説明資料より

売上高・営業利益の四半期推移

(左軸：売上高) トレックス : ■ ■
(単位：百万円) フェニテック : ■ ■

(右軸：営業利益)
(単位：百万円)



(単位：百万円)

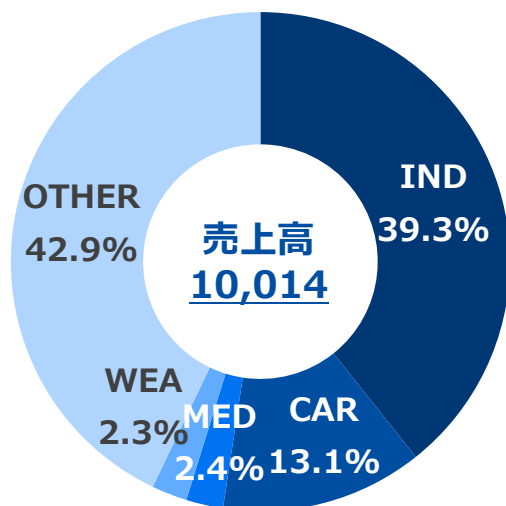
科目	24年3月期末	25年3月期末	対前期末増減
資産	36,636	33,607	▲3,029
負債	16,083	16,207	124
純資産	20,552	17,400	▲3,152

＜参考＞ キャッシュ・フロー関連指標の推移

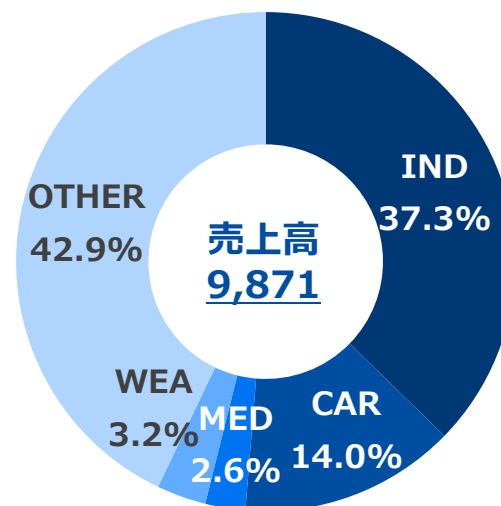
科目	24年3月期末	25年3月期末	対前期末増減
有利子負債	11,314	12,984	1,670
自己資本比率	56.1%	51.8%	▲4.3pt
D/Eレシオ	0.55	0.74	0.19

トレックス／フェニテック 各単体

TOIREX



24.3期実績



25.3期実績

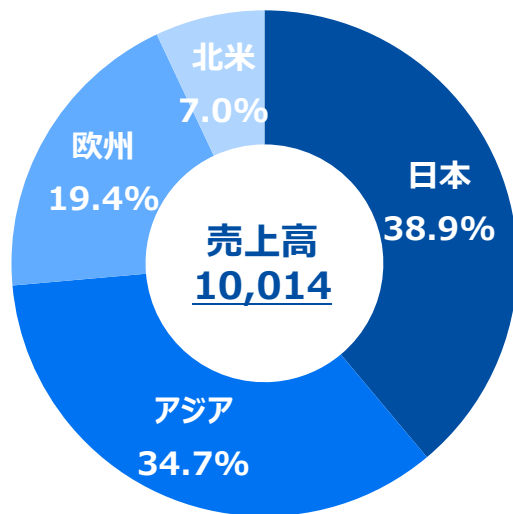
(単位：百万円)

アプリケーション		24.3期		25.3期		対前年同期比 増減率
		売上高	構成比	売上高	構成比	
IND	産業機器	3,934	39.3%	3,686	37.3%	▲6.3%
CAR	車載機器	1,315	13.1%	1,379	14.0%	4.9%
MED	医療機器	240	2.4%	253	2.6%	5.4%
WEA	ウェアラブル機器	226	2.3%	315	3.2%	39.4%
OTHER	その他機器	4,299	42.9%	4,238	42.9%	▲1.4%

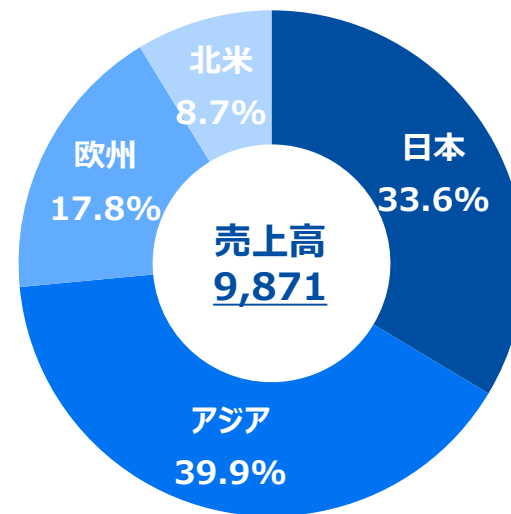
※注：アプリケーションの分類は変更することがあります。

2025年3月期 ～地域別売上高（トレックス）

TOIREX



24.3期実績

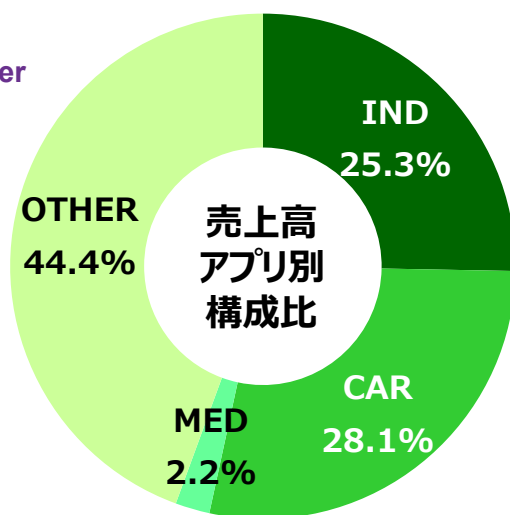


25.3期実績

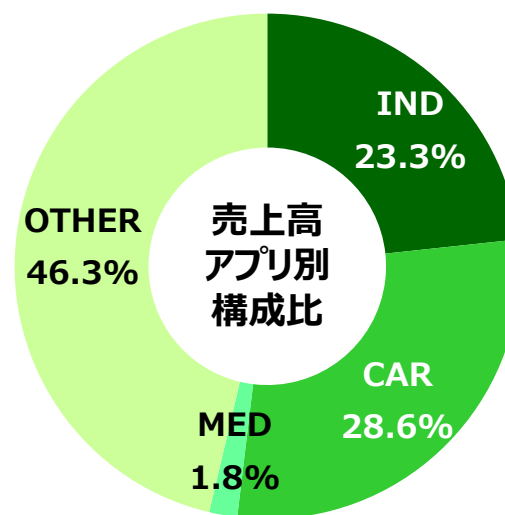
(単位：百万円)

地域 (D-in)	24.3期		25.3期		対前年同期比 増減率
	D-in 売上高	構成比	D-in 売上高	構成比	
日本	3,892	38.9%	3,317	33.6%	▲14.8%
アジア	3,477	34.7%	3,942	39.9%	13.4%
欧州	1,942	19.4%	1,754	17.8%	▲9.7%
北米	703	7.0%	858	8.7%	22.0%
平均為替レート (1\$=)	144.4円		152.4円		—

D-in 売上高：デザイン・イン・ベース売上高。当社の製品を搭載した製品が企画・設計され、実質的に受注を獲得した地域をベースとした売上高



24.3期実績



25.3期実績

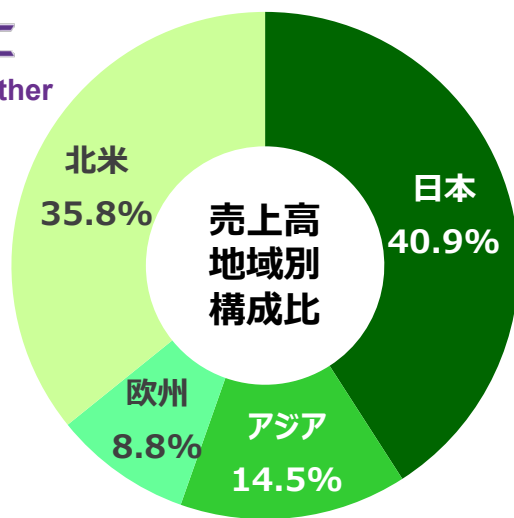
(単位：百万円)

アプリケーション		24.3期		25.3期		対前年同期比 増減率
		売上高	構成比	売上高	構成比	
IND	産業機器	4,287	25.3%	3,553	23.3%	▲17.1%
CAR	車載機器	4,757	28.1%	4,372	28.6%	▲8.1%
MED	医療機器	379	2.2%	281	1.8%	▲25.9%
OTHER	その他機器	7,536	44.4%	7,060	46.3%	▲6.3%

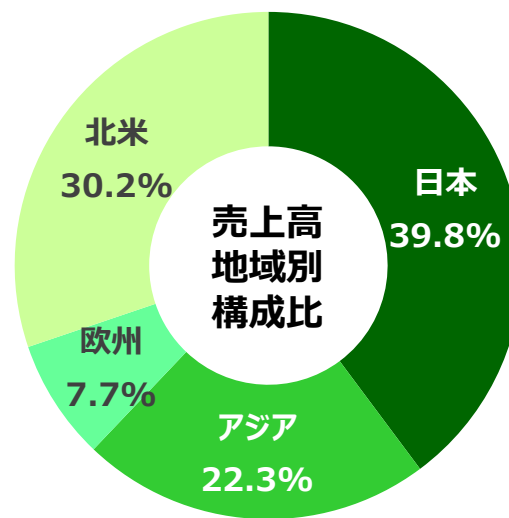
※注：アプリケーションの分類は変更することがあります。

トレックス・セミコンダクター向けの内部取引分を含む

2025年3月期 ～地域別売上高（フェニテック）



24.3期実績



25.3期実績

※ 顧客の所在地別に区分しています。

(単位：百万円)

地域（顧客）	24.3期		25.3期		対前年同期比 増減率
	売上高	構成比	売上高	構成比	
日本	6,936	40.9%	6,073	39.8%	▲12.4%
アジア	2,462	14.5%	3,398	22.3%	38.0%
欧州	1,490	8.8%	1,182	7.7%	▲20.7%
北米	6,071	35.8%	4,613	30.2%	▲24.0%
平均為替レート（1\$=）	144.4円		152.4円		

※注：日本には、トレックス・セミコンダクター向けの内部取引分を含む

2026年3月期 業績予想

2026年3月期 業績予想 P/L概要及び主要指標

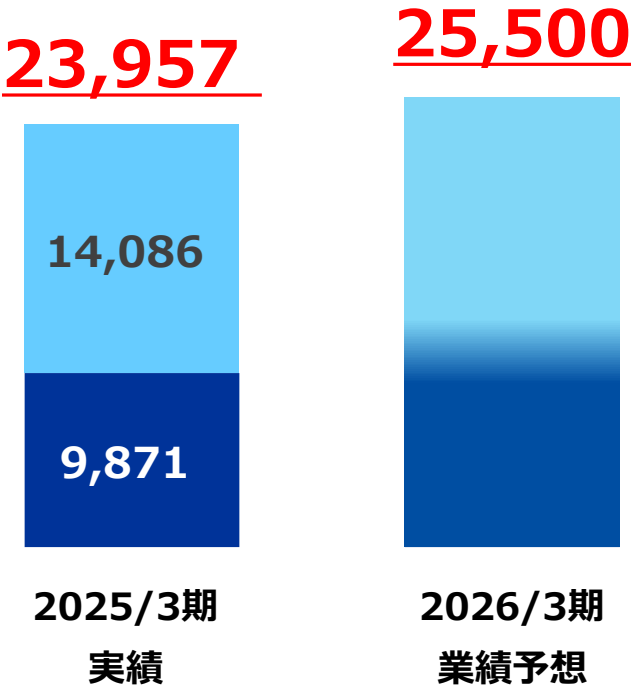


(単位：百万円)

	25.3期 通期実績	26.3期 業績予想	対前年 同期比 増減率	備考
売上高	23,957	25,500	+ 6.4%	
営業損益	▲ 632	400	-	
営業利益率	▲ 2.7%	1.6%	-	
経常損益	▲ 820	400	-	
親会社株主に 帰属する当期純損益	▲ 2,358	300	-	
EPS（円）	▲ 215.75	27.87	-	
平均為替レート（1\$=）	¥152.4	¥145.0	-	
減価償却費	2,468	2,000	▲ 19.0%	
設備投資	2,950	2,740	▲ 7.1%	

(単位：百万円)

- : トレックス
- : フェニテック寄与分



年後半からの半導体市況の回復を想定し、増収と予想

(単位：百万円)

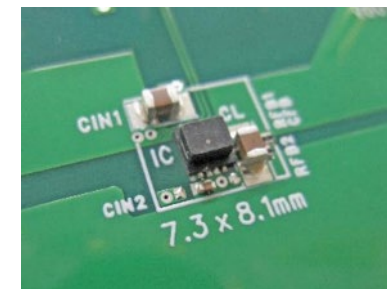
	2025年3月期 実績	2026年3月期 業績予想	対前年増減率
売上高	23,957	25,500	+ 6.4%

売上向上に関する施策

- ・ 高付加価値製品の拡販

 - ⇒ 高耐圧 コイル一体型DC/DCコンバータ

 - ⇒ 高耐圧 DC/DCコンバータ



- ・ FAEによる新規顧客開拓

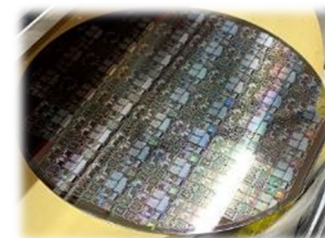
- ・ CV充電リチウム二次電池用 リファレンス回路

 - ⇒ 日本ガイシ株式会社のLTO電池 “EnerCera” ETシリーズ

 - ⇒ ニチコン株式会社 “SLB” シリーズ リファレンス回路

- ・ 化合物半導体

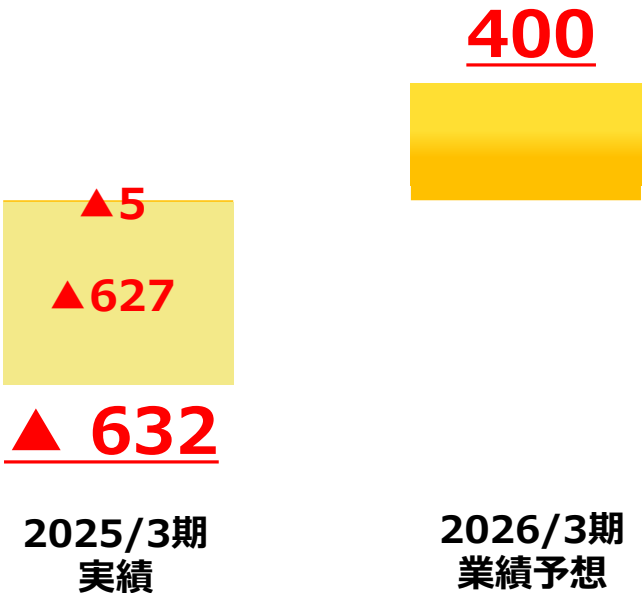
 - ⇒ SiC ファウンドリ / SBD、MOSFET、カスタマイズ



- ・ チャイナプラスワン

(単位：百万円)

- : トレックス
- : フェニテック寄与分



売上の増加とそれに伴う粗利率の改善と社内改善活動による経費の低減により、増益と予想

(単位：百万円)

	2025年3月期 実績	2026年3月期 業績予想	対前年増減率
営業損益	▲632	400	—

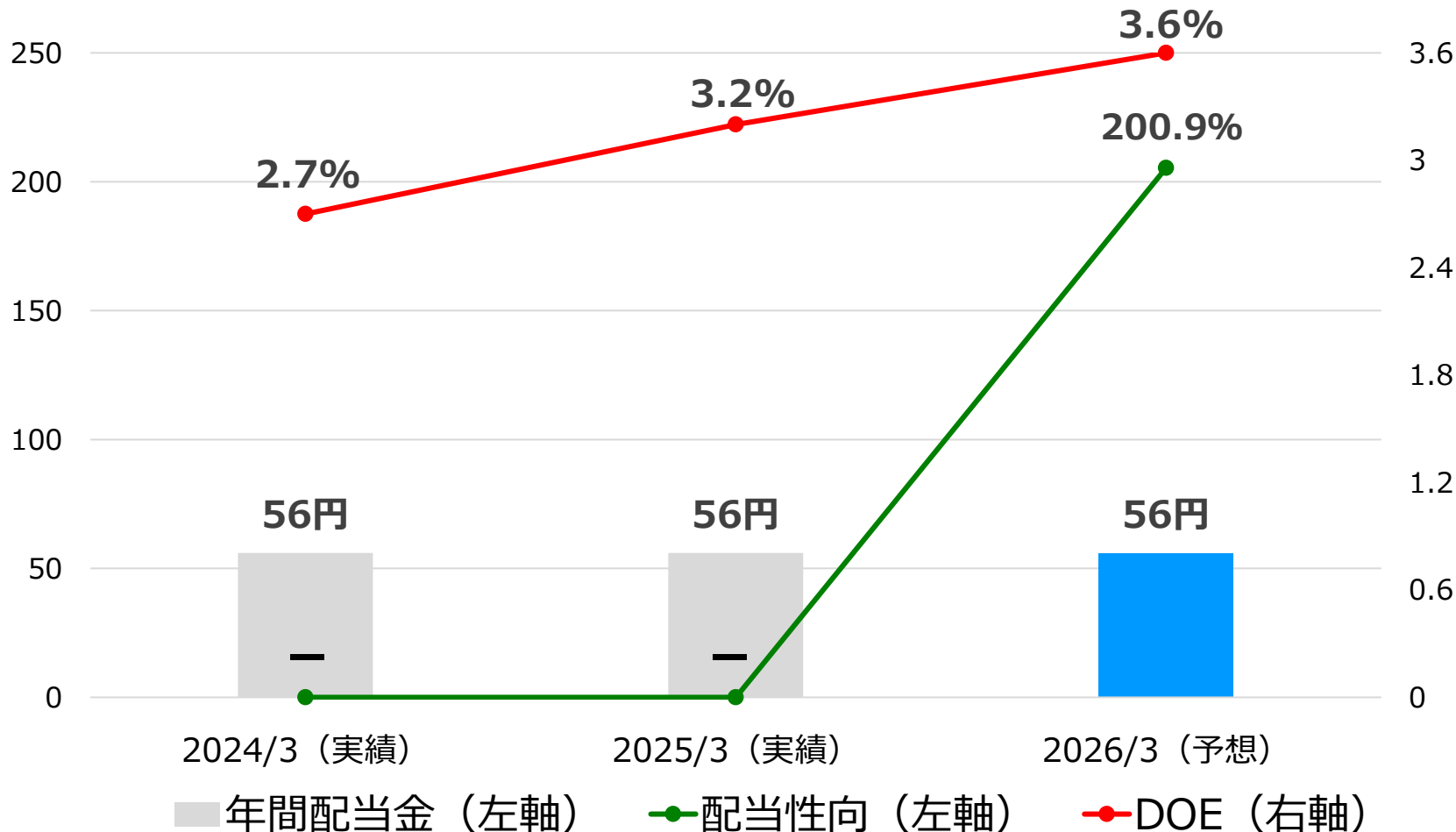
株主還元

配当につきましては、業績水準を反映した利益配分として
連結配当性向20%以上、安定的かつ継続的な株主還元
の拡充として**株主資本配当率（D O E）3%程度**を当面
の目標として実施しております。

連結配当性向20%以上、D O E 3%程度を目標として還元

配当金：円
配当性向：%

DOE：%



トピックス

2月7日に半導体製品の世界的IDMメーカーであるPANJIT社と、当社の後工程を行うTVS社の持分の全部または一部を譲渡することを目的とする基本合意書を締結したことを発表。

名称	PANJIT INTERNATIONAL INC.
所在地	No. 24, Gangshan N. Rd., Gangshan Dist., Kaohsiung City , Taiwan
売上高 (2023年12月期)	12,707,319千台湾ドル (597億24百万円 / 1台湾ドル=4.7円換算)
資本金	3,821,149千台湾ドル
設立年月日	1986/05/20

PANJIT Global Footprint at a Glance



トレックスグループのメリット

PANJIT社の製造技術力と、ファブレスメーカーである当社の設計開発力を活かし、相互にシナジー効果を発揮。

パッケージ技術の高度化と全体的な競争力を向上

Assembly Capacity



※同社IR資料より抜粋

サステナビリティ基本方針

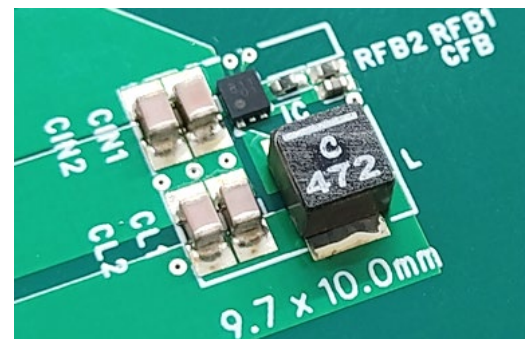
トレックスグループは、「価値ある製品を通じた豊かな社会の実現と地球環境の保全」を掲げ、環境・社会に貢献するという考えを経営の中心に据え、共存・共栄の精神で、すべてのステークホルダーとともにサステナビリティ推進に取り組んでまいります。

マテリアリティ

マテリアリティ	基本方針
社会課題解決に向けた高付加価値製品の提供	トレックスグループの製品は、世界中のあらゆる分野で使用される電子機器に広く採用されています。持続可能な社会の実現に向け、高付加価値な半導体製品を提供することで、社会課題の解決と事業の成長の両立を目指しています。
多様で個性ある人財が活躍できる環境の整備	トレックスグループの強みは、長年にわたる半導体事業で培った技術力と、市場のニーズを的確に捉える力です。この力を次世代に継承し、急速に変化する時代に対応できる専門性と独創性を備えた組織力を構築するため、人財の確保と育成を推進していきます。また、多様な個性と専門性を活かし、従業員が自発的に活躍できる職場環境の整備にも注力していきます。
地球環境保全に向けた取組の推進	トレックスグループは、気候変動を含む環境問題を、持続可能な社会の実現に向けた重要な課題と捉えています。バリューチェーンを通じて、環境負荷を軽減する半導体製品を提供することで、省エネや省資源化に貢献し、環境保全に取り組んでいきます。
すべてのステークホルダーのための経営基盤の確立	トレックスグループは、事業に携わるすべてのステークホルダーが共に繁栄することを目指しています。グループの継続的な事業成長を通じて、社会に貢献し、利益の創出を実現していきます。中長期的な企業価値の向上に向け、堅実な経営基盤を維持し、リスクマネジメントを推進することで、さらなる成長を追求していきます。

PWM/PFM制御 36V高耐圧 600mA 降圧DC/DCコンバータ XC9704/XC9705 シリーズ

- ・ F-PWM、PWM/PFM自動切換制御
- ・ 同期整流 ドライバ FET内蔵
- ・ 入力電圧範囲 3.0V ~ 36V
- ・ SOT-89-5、DFN1820-6G



36V 600mA 降圧DC/DC
小型／低消費ソリューション

製品の特長

- ・ 高効率、低リップル電圧
- ・ 発信周波数：1.2MHz、2.2MHz
- ・ パワーグッド、UVLO、ソフトスタート外調
- ・ 電流制限、サーマルシャットダウン
- ・ 小型ソリューションを提供

ターゲットアプリケーション

12V/24Vラインからの小型／低消費が必要な機器
工場・ビル・施設などのセンサ／セキュリティ機器
白物家電：エアコン等

<< 商談・採用事例 >>

- ・ 家庭用 エアコン
- ・ 業務用 エアコン、リモコン／コントローラ
- ・ 産業用カメラモジュール
- ・ FA用 各種センサー類
- ・ デジタル家電
- ・ 家電製品、白物家電

PWM/PFM制御 36V高耐圧 600mA 降圧DC/DCコンバータ XCL247/XCL248 シリーズ

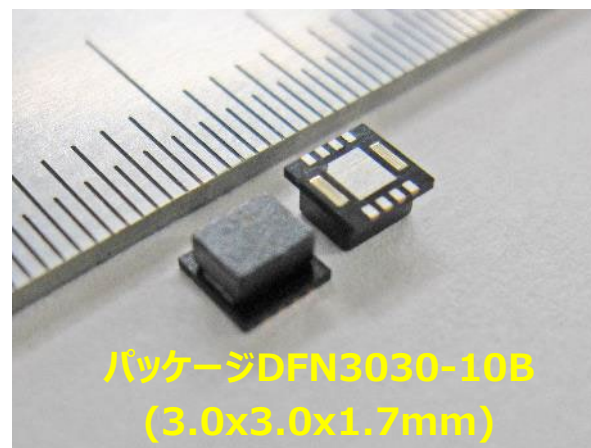
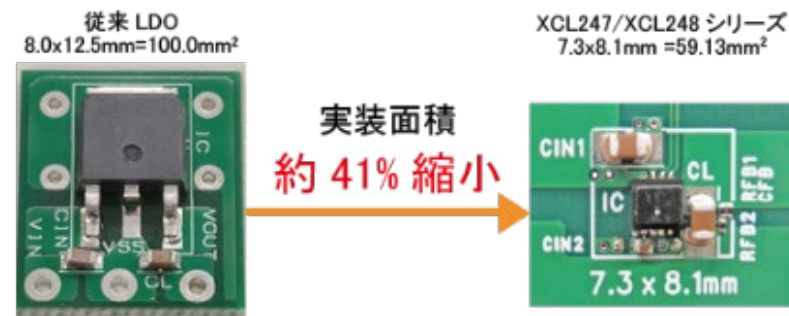
- ・ F-PWM、PWM/PFM自動切換制御
- ・ 同期整流 ドライバ FET内蔵
- ・ 入力電圧範囲 3.0V ~ 36V
- ・ 動作温度範囲 -40℃~105℃

製品の特長

- ・ 徹底した小型化で約41%縮小（右図）
- ・ 電力変換の高効率化で発熱を大幅低減（右図）
- ・ ICの上部にコイルを実装する、トレックス独自の
パッケージ採用で、超小型化を実現

ターゲットアプリケーション

- ・ 12V/24Vラインからの小型/低消費が必要な機器
- ・ FA機器、産業用センサー、セキュリティシステム、
- ・ 家電製品、高耐圧LDOの置き換え、等々



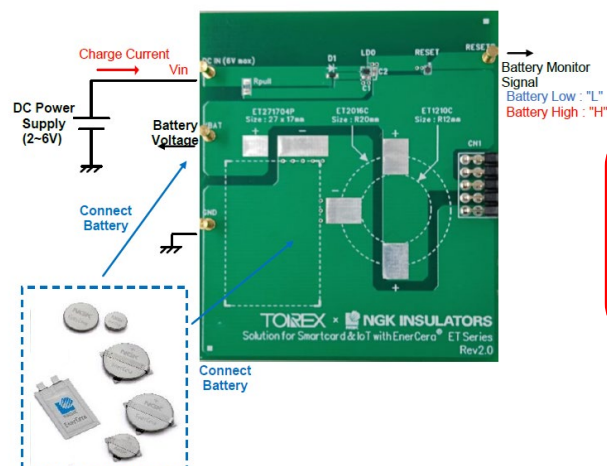
動作温度105℃ 定電圧充電リチウム二次電池用 電圧検出器 XC6142シリーズ

製品の特長

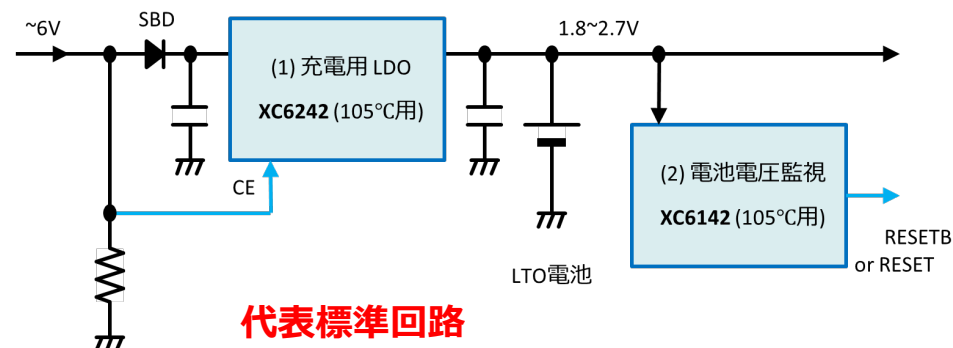
- ・ 2.3V系 小型リチウム二次電池に最適化
- ・ 動作周囲温度：-40℃～105℃

ターゲットアプリケーション

CV充電対応二次電池の電圧監視
電気二重層コンデンサの電圧監視

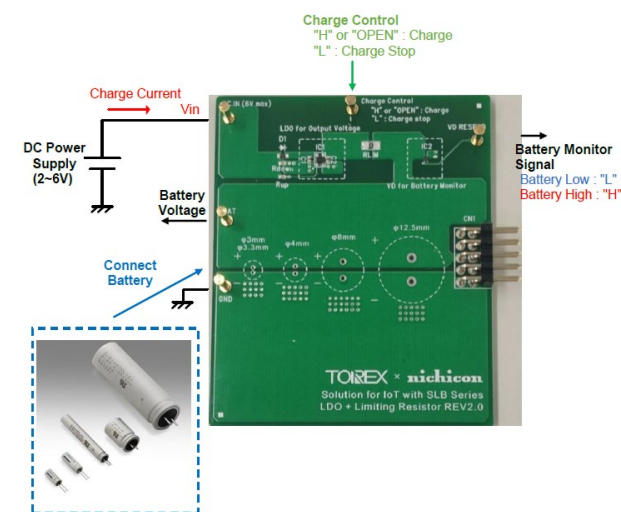


NGK INSULATORS “EnerCera” ET シリーズ用 評価ボード



代表標準回路

採用 リファレンス回路例
NGK EnerCeraシリーズ
Nichicon SLBシリーズ



Nichicon SLB シリーズ用 評価ボード

プライム市場の上場維持基準への適合状況

当社は、2025年3月31日時点において、東京証券取引所プライム市場における上場維持基準について、下記のとおり不適合が生じておりますことをお知らせいたします。

上場維持基準6項目のうち5項目は充たしているものの、「流通株式時価総額」が81.2億円と基準値100億円以上を充たしておりません。

当社は、流通株式時価総額の基準に関し、上場維持基準を充たすべく、各種取組みを進めて参ります。

	株主数	流通株式 数	流通株式 時価総額	流通株式 比率	1日平均 売買代金	純資産の額
当社の状況 (基準日時点)	3,842人	66,611 単位	81.2億円	57.6%	5千176万円	174億円
上場維持基準	800人 以上	20,000 単位以上	100億円 以上	35%以上	2千万円 以上／日	純資産の額が 正
適合状況	適合	適合	不適合	適合	適合	適合

時価総額

×

流通株式比率

=

流通株式時価総額

上場維持基準の未達項目である「流通株式時価総額」の充足に向けて、収益性を改善することを背景として株価を上昇させ、「時価総額」を向上させることで、2026年3月期末日までに未達項目の適合を目指します。

主要製品である電源ICの売上及びディスクリート製品のファウンドリ売上拡大による収入の拡大に注力するとともに、高付加価値製品の販売強化による収益率の改善、社内改善活動による経費の低減を進め、収益性の向上を行います。

また、今年度中には2026年度から始まる新たな中期経営計画を策定し、中長期の成長戦略やサステナビリティ情報、資本コストを意識した経営に関する情報等の開示することで、株式バリュエーションの上昇にも取り組んでまいります。

フェニテックセミコンダクター

ファウンドリ受託

SiC

GaN

GaAs

Ga₂O₃

主要化合物半導体(SiC・GaN・GaAs・Ga₂O₃) デバイスの
ファウンドリをフレキシブルに受託できるのが、当社の“強み”です

ファウンドリ
Ga₂O₃

- ✓ 広いバンドギャップ
- ✓ 高い絶縁破壊電界強度
- ✓ 低スイッチング損失
- ✓ 低コスト基板製造の可能性

Ga₂O₃(酸化ガリウム)とは

酸化ガリウム半導体は、従来のシリコン半導体と比較して、より高い耐圧と低い電力損失を実現できます。ワイドバンドギャップであるため、高温や高周波環境下での動作にも優れています。
また、他の次世代半導体材料に比べて、基板の製造コストを大幅に削減できる可能性があり、電力変換効率の向上やデバイスの小型化に貢献することが期待されています。

ノベルクリスタルテクノロジー社よりファウンドリを請け負い、
酸化ガリウムデバイスの試作生産を行なっています

生産ノウハウの蓄積

- ✓ 次世代パワー半導体材料として注目されるGa₂O₃の
ファウンドリにいち早く対応、今後Ga₂O₃デバイス開発
・生産の顧客ニーズに応え続けていきます

ファウンドリ SiC

- ✓ 広いバンドギャップ
- ✓ 高い絶縁破壊電界強度
- ✓ 高い電子移動度
- ✓ 高い熱伝導率
- ✓ 低いオン抵抗

SiC(炭化ケイ素)とは

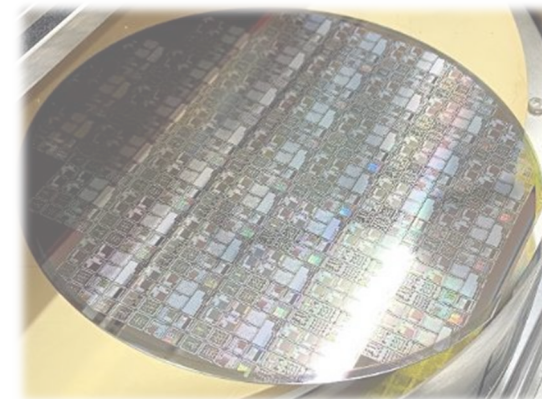
SiC半導体は、シリコンに対し高耐圧・高耐熱性、低損失、高速動作に優れます。これにより、電力変換効率が向上し、デバイスの小型化・軽量化が可能です。

応用分野は多岐に渡り、特に電気自動車のインバータやオンボードチャージャー、鉄道車両の駆動システム、産業機器のパワーコンディショナ、再生可能エネルギー分野などで実用化が進んでいます。高効率な電力制御を実現し、省エネルギー化に貢献する次世代パワー半導体として注目されています。

- ・ 当社SiCファウンドリは、SBD,MOSFET以外にも、要素開発・試作フェーズのものを含めると様々な製品の生産を担っています

生産ノウハウの蓄積

- ✓ 今後も、ますます増えていくSiCデバイス生産の顧客ニーズにフレキシブルに応え続けていきます

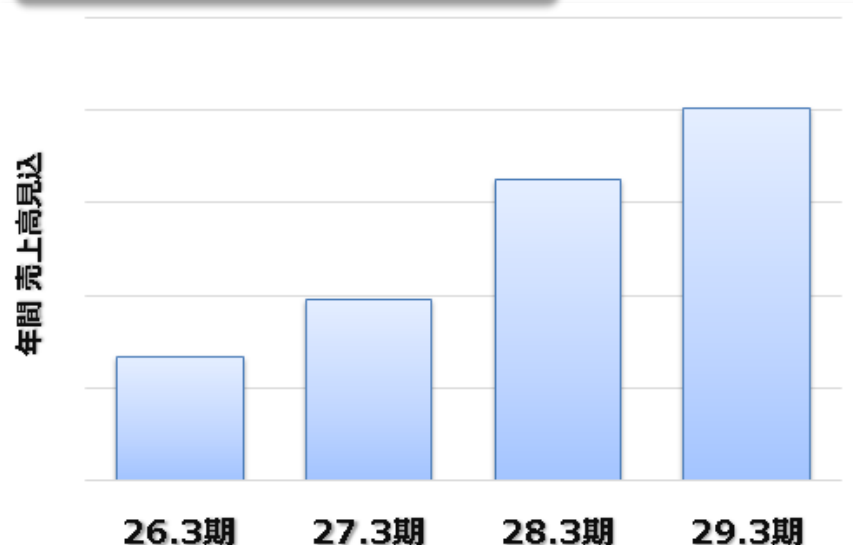


ファウンドリ受託

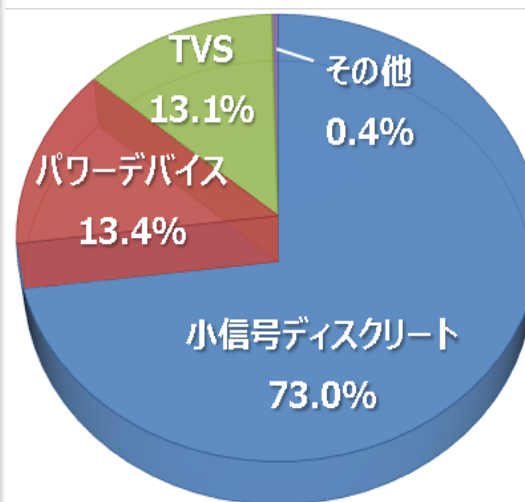
新規受注案件

- ✓ 当社主力の一つである小信号ディスクリートを中心に、新規ファウンドリ受託案件が好調です
- ✓ 中華圏の企業がチャイナプラスワン戦略により、ファウンドリ先を国外に移す流れがあり、当社に受託する案件も増加しています

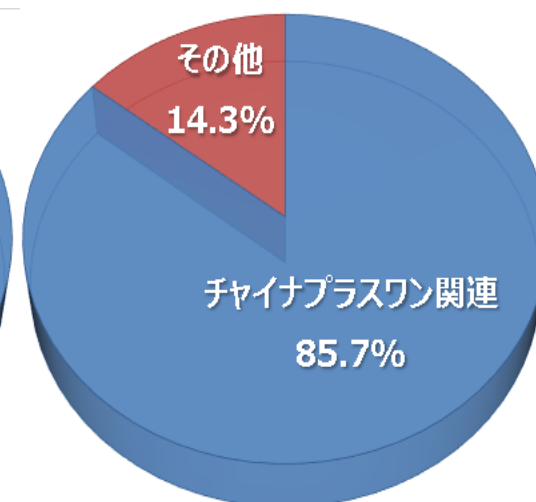
新規受注案件売上高見込み



新規受注案件製品比率



「チャイナプラスワン」関連比率



- ✓ 当社は、地政学的リスク分散、中国におけるコスト上昇、サプライチェーン強靱化などを背景に、各企業のチャイナプラスワン戦略の継続を見込んでおり、今後も成長戦略として関連案件を積極的に取り込んでいきます

Si製品開発

新たなパワーデバイス開発により更なる売上アップを目指す

Low Vth MOSFET

量産中

- ・製品ラインナップ拡充を継続

スプリットゲート型MOSFET

60V プロセス開発成功し、狙い特性獲得

- ・26.3期Q3 量産予定
- ・製品ラインナップ拡充を継続

100V

150V

フィールドストップ型IGBT

650V/40A プロセス開発成功し、狙い特性獲得

- ・26.3期Q2 量産予定
- ・製品ラインナップ拡充を継続

1200V/75A

SiC製品開発

新たなパワーデバイス開発により更なる売上アップを目指す

SBD

自社開発品

量産フェーズ

650V 10A Gen.2,3

650V 20A Gen.2,3

1200V 10A Gen.2,3

650V 6,8,10A Gen.4

✓ 今後も市場要望にスピーディなシリーズ拡充で対応

- ・第2,3,4世代 サンプル提供中/顧客評価中 26.3期Q1量産予定
- ・目標耐圧2200V,3300V品を開発中

MOS FET

自社開発品

1200V 20A Planar/Trench

1200V 40A Planar

1200V 80A Planar

✓電流ラインナップシリーズ展開 試作中

プレーナー型

- ・サンプル提供中/顧客評価中 26.3期Q4量産予定
- ・ベースプロセスライン完成 ラインナップ化を進める
(1200V 40A /1200V 80A)

トレンチ型

- ・開発中

広島大学 学長定例記者会見

2025.04.24

会見概要

当社は、広島大学との共同研究により、高温や高放射線環境下で動作する半導体チップを鹿児島工場で試作製造し、広島大学行われた記者会見で、共同研究の成果として発表しました。

この半導体チップは、SiC(炭化ケイ素)を使用した集積回路で、SiC集積回路の量産ファブでの試作製造は、世界初の取組みとなります。

デバイス設計は主に広島大学が担当し、製造プロセス検討を合同で行い、鹿児島工場6インチ量産ファブで生産しました。

1年弱という短期間で試作ウェハーを完成することができました。今後は幅広い分野での利用を期待し、量産準備を進めます。



広島大学学長定例記者会見の様子

左は広島大学 黒木副所長

右は当社代表取締役 石井(陪席者として登壇)

合同チーム
Since 2024.5

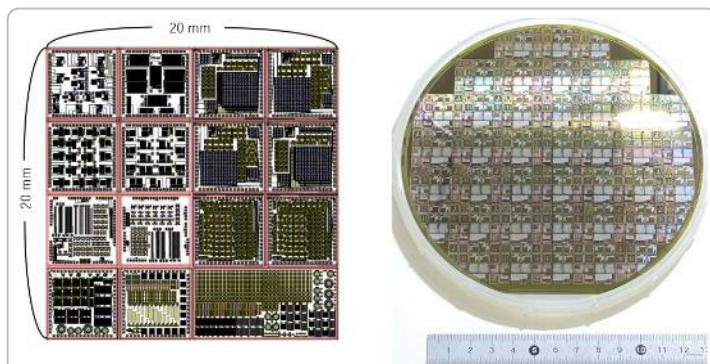


プロセス検討
回路設計
デバイス評価

Phenitec
For Further Growth Together

プロセス検討
量産Fab試作

成果の内容



左は試作製造された集積回路などの図面
右は試作製造されたSiCウェハー

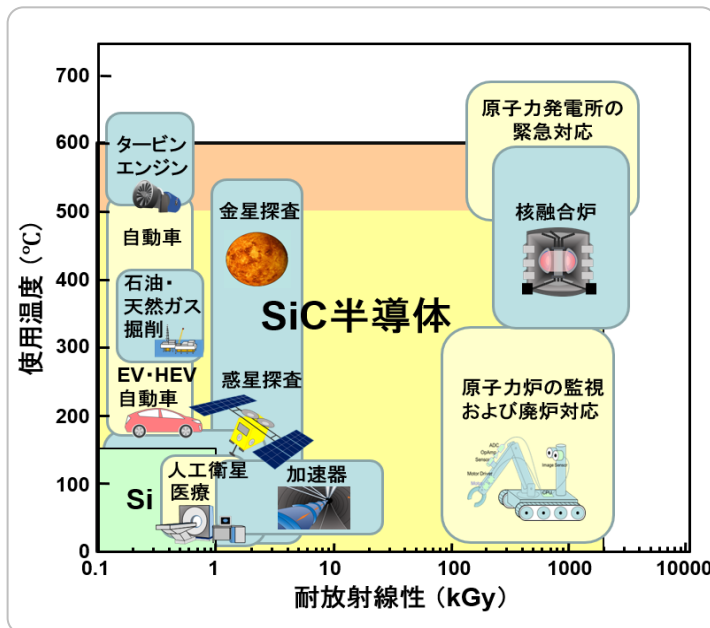
合同チームにより、新たにSiC集積回路専用の製造プロセスを新たに構築

試作製造したSiC集積回路は、500℃の高温や高い放射線量の中でも動作

シリコン半導体チップの一般的制限 最大温度 150℃、耐放射線性1kGy(キロ・グレイ)程度を越え、半導体の利用領域を大幅に広げる

応用分野はシリコン半導体が使用できない領域

EV、原発の廃炉作業、粒子線医療、宇宙開発、次世代原子炉・核融合炉など



今後は...

- ✓ SiC集積回路設計・製造の環境整備
- ✓ SiC集積回路の大規模化
- ✓ 応用分野システムメーカーとの連携・ファウンドリ立ち上げの為にSiC集積回路の共通プラットフォーム構築へ

Powerfully Small!

常に豊かな知性と感性を磨き、
市場に適応した価値ある製品を創出し、
豊かな社会の実現と
地球環境の保全に貢献するとともに、
私たちの事業に携わるすべての人々が
共に繁栄すること



本資料に記載された内容は、2025年5月20日現在において一般的に入手可能な情報と、合理的と判断する一定の前提に基づき、当社が作成したものです。

本資料に記載されている当社の中期計画、見通し等に関する記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクと不確実性を内包するものです。

実際の業績は、これらの要素により本資料の記載内容と大きく異なる可能性があります。

投資に関するご決定をされる際、本資料のみに全面的に依拠することはお控えいただき、みなさまご自身のご判断でなされるようお願い致します。